







	<h2>SI9424BDY-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI9424BDY-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 5.6A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI9424BDY-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 35598 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI9424BDY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 5.6A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	35598 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 5.6A (Ta) 1.25W (Ta) Surface Mount 8-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	1.25W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 7.1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	850mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±9V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI9424BDY-T1-E3TR

SI9424BDY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI9424BDY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI9424BDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI9424BDY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI9424BDY-T1 VISHAY VISHAY SOP8</p>	 <p>SI9424BDY-T1 VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p>SI9424BDY VISHAY SI9424BDY VISHAY</p>	 <p>SI9424BDY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.6A 8-SOIC</p>
 <p>SI9424BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.6A 8SOIC</p>	 <p>SI9424DY AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 8A 8-SOIC</p>	 <p>SI9424B VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p>SI9424BDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.6A 8SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI9407BDY-T1-GE3	↔ SI9407DY	⇒ SI9407DY-T1-E3	D SI9407DY-T1-GE3	⇒ SI9410ADY-T1-E3
⊖ SI9410ADY-T1-GE3	⊕ SI9410BDY	D SI9410BDY-T1-E3	⇒ SI9410BDY-T1-E3	⇒ SI9410BDY-T1-E3.
⊕ SI9410BDY-T1-GE3	⊖ SI9410BDY-T1-GE3	⊕ SI9410DY	↔ SI9410DY-NL	⇒ SI9410DY-T1
D SI9410DY-T1-E3	⊕ SI9410DY-T1-E3.	⊖ SI9410DY-T1-GE3	⊕ SI9410DY-T1	⇒ SI9420DY
⇒ SI9420DY-T1	↔ SI9420DY-T1-E3	⊕ SI9420DYTI	⊖ SI9422DY-T1-E3	⇒ SI9424ADY-T1-E3
↔ SI9424BDY-T1-E3	⇒ SI9424BDY-T1-GE3	D SI9424BDY-T1-GE3	⊕ SI9424DY	⊖ SI9424DY
⊕ SI9424DY-T1	D SI9424DY-T1-E3	⇒ SI9424DY-T1-E3.	↔ SI9426DY	⇒ SI9426DY-T1
⊖ SI9426DY-T1-E3	⊕ SI9428DY-T1-E3	↔ SI9428DY-T1-GE3	⇒ SI9430DY	⇒ SI9430DY-T1
⊕ SI9430DY-T1-E3	⊖ SI9430DY-T1-E3.	⊕ SI9430DY-T1-GE3	D SI9431DY-T1	⇒ SI9431DY-T1-E3
↔ SI9433ADY-T1-E3	⊕ SI9433ADY-T1-GE3	⊖ SI9433BDY-T1-E3	⊕ SI9433BDY-T1-E3	⇒ SI9433BDY-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited